



Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Crescimento de filmes finos de Mn_xO_y e Cu_xO_y sobre Cu (111)

Gabriel Alves^{1,2}, G. Felix², R. Caetano², Fernando Stavale² ¹ Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ ² Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)

> Rio de Janeiro, Julho 2019

Introdução

- O estudo dos óxidos metálicos é de importância fundamental na compreensão de suas estruturas cristalinas e eletrônicas.
- Aplicações: monitoramento de gases, catálise, corrosão, conversão de energia e entre outras.



https://www.mdpi.com/2079-6412/8/12/425/htm



https://www.touchsustentavel.com.br/como-funciona-o-painel-fotovoltaico/

Introdução

- O microscópio de varredura por tunelamento (scanning tunneling microscope - STM) é o equipamento fundamental para gerar imagens dessas estruturas cristalinas e eletrônicas dos materiais, átomo por átomo.
- O STM explora as irregularidades nas superfícies, tais como átomos ausentes, impurezas ou defeitos intersticiais.



Teoria do STM (Scanning Tunneling Microscope)

- 2 eletrodos são dispostos frente a frente no vácuo de modo que haja uma barreira de potencial entre ambos (ponta e cristal).
- Na Mecânica Quântica, os elétrons são representados por funções de onda.
- Se a distância entre os eletrodos for muito pequena, a probabilidade do elétron passar de um componente a outro é grande.

$$\Psi = e^{\pm k.z}$$
, sendo $k^2 = \frac{2m}{\hbar}$. $(V_b - E)$



Estruturas do metal

Tipo de metal

Estrutura

Parâmetro de rede

Distancia Interatômica

Cu



a = 3.58 Å b = 2.53 Å



Figura 1. 10,0nm x 10,0nm. $I_t = -0,15 nA. V_t = -0,34 V.$ $P = 2,6.10^{-9} Torr$

Figura 2. Degrau atômico: 1,435 Å.



Figura 3. 4,2nm x 3,7nm. $I_t = -0,16 nA. V_t = -0,34 V.$ $P = 2,6.10^{-9} Torr$ Figura 4. Distância interatômica: 2,83 Å.

Mn_3O_4 (110)/Cu (111)



Figura 5. $P = 2,6.10^{-7} Torr$

Mn_3O_4 (110)/Cu (111)



Figura 6. $P = 2,6.10^{-7} Torr$

$Mn_x O_y$ (110)/Cu (111)

Figura 7. 7nm x 7 nm. V = 0.97 V It = -0.63 nA. $P = 5.0.10^{-8} Torr$

Figura 8. 7 nm x 7 nm. V = -0.66 V It = -0.88 nA. $P = 2.6.10^{-8} Torr$

$Cu_x O_y$ (111)/ Cu (111)

Figura 9. 20,0 nm x 20,0 nm. V_t = 0,55V I_t = 2,12 nA. P = 5,2.10⁻⁸ Torr Figura 10.MATENCIO, Sonia. BARRENA, Esther. OCAL, Carmen. Coming across a novel copper oxide 2D framework during the oxidation of Cu (111). Cross Mark. (e) I_t = 194 pA, V_t = 0.47 V. (f) I_t = 100 pA, V_t = 0.74 V.

Figura 11. 13,8nm x 5,9nm. $I_t = -0,34 nA. V_t = -0,29 V.$ $P = 5,4.10^{-8} Torr$ Figura 12. STRÄTER, Hendrik. FEDDERWITZ, Hanna. GROB, Boris. NILIUS, Niklas. Growth and Surface Properties of Cuprous Oxide Films on Au (111). The Journal of Physical Chemistry.

Conclusão

- Conseguimos obter uma boa resolução atômica do cobre.
- O resultado esperado do óxido de manganês não era compatível com a literatura, logo crescemos filme fino de óxido de cobre para confirmar que não era óxido de manganês.
- Nas próximas etapas nós pretendemos mudar a metodologia de crescimento de filme para evitar o crescimento do óxido de cobre em vez do óxido de manganês.

OBRIGADO!

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Crescimento de Filme EBE (Electron-beam evaporation)

https://www.focus-gmbh.com/resources/UHV-Instruments/e-beamevaporation/EFMBroschuere2016Rev5.pdf

http://web.tuat.ac.jp/~usuilab/English/depo.html